

FH8210

单串高精度二合一锂电池保护芯片(可外接MOS)

1. 概述

FH8210 内置有高精度电压检测电路和延迟电路, 通过检测电池的电压、电流, 实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护与一身, 同时鉴于CPC-8的创新型封装, FH8210把低内阻的N-MOS也集封在一起, 而且又能兼容外扩MOS的需求, 方便客户应对不同电流需要。

2. 特点

FH8210 具备如下特点:

(1) 高精度电压检测电路

- | | | |
|------------|--------|-----------------------|
| ● 过充电检测电压 | 4.280V | 精度 $\pm 30\text{mV}$ |
| ● 过充电释放电压 | 4.080V | 精度 $\pm 50\text{mV}$ |
| ● 过放电检测电压 | 3.000V | 精度 $\pm 50\text{mV}$ |
| ● 过放电释放电压 | 3.000V | 精度 $\pm 50\text{mV}$ |
| ● 放电过流检测电压 | 80 mV | 精度 $\pm 15\text{mV}$ |
| ● 充电过流检测电压 | -100mV | 精度 $\pm 40\text{mV}$ |
| ● 负载短路检测电压 | 580mV | 精度 $\pm 220\text{mV}$ |

(2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)

(3) 休眠功能

(4) 低耗电流

- 工作模式 典型值 $3.0\mu\text{A}$, 最大值 $6.0\mu\text{A}$ ($V_{DD}=3.9\text{V}$)
- 休眠模式 最大值 $0.1\mu\text{A}$ ($V_{DD}=2.0\text{V}$)

(5) 连接充电器的端子用高耐压设计(CS 端子和 OC 端子,绝对最大额定值是 15V)

(6) 允许向 0V 电池充电功能

(7) 宽工作温度范围: $40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

(8) 小型封装: CPC-8

(9) 无卤素绿色环保产品

(10) 高耐压内置 MOSFET : $BV_{DSS}(\text{MIN}) 20\text{V}$

3. 应用领域

- 各种可充电锂电池

4. 封装、脚位信息

- CPC-8

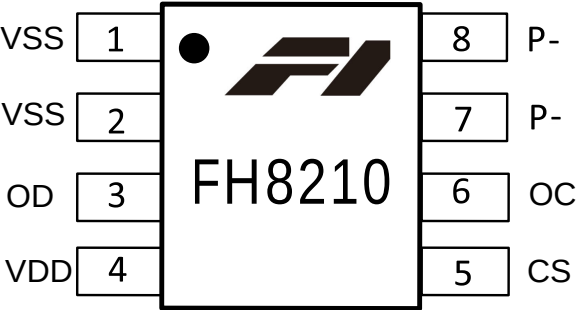
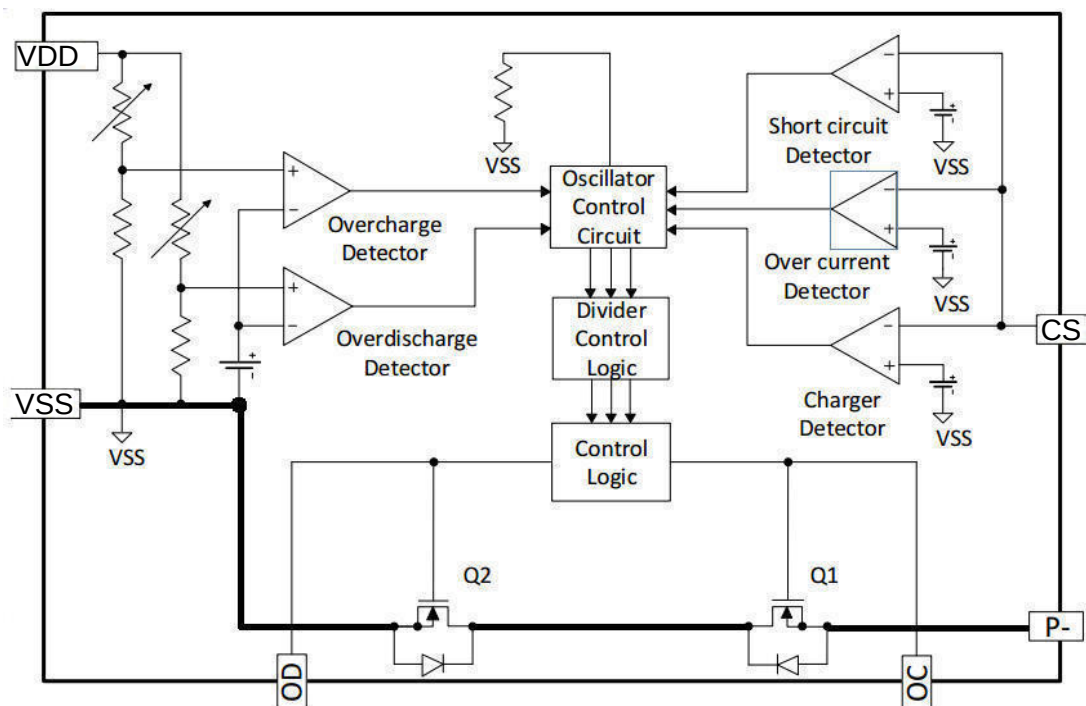


图 1 FH8210 管脚排列图（不成比例）

5. 引脚描述 表 2

引脚名称	引脚序号	I/O	引脚功能
OD	3	O	放电控制输出端； 与外部放电控制 N MOS 管的栅极（G 极）相连。
CS	5	I	充/放电电流检测输入端； 该引脚通过一个限流电阻（一般为 1KΩ）与外部充电控制 N MOS 管的源极（S 极）相连，从而检测充/放电电流在两个 N MOS 管上形成的压降。
OC	6	O	充电控制输出端；与外部充电控制 N MOS 管的栅极（G 极）相连。
P-	7、8	POW	充电器负极；与被保护电路的负极相连。
VDD	4	POW	电源输入端；与供电电源（电池）的正极连接，该引脚需用一个 0.1μF 的瓷片电容去藕。
VSS	1、2	POW	电源接地端；与供电电源（电池）的负极相连。

6. 方框图



7. 绝对最大额定值

表 3、绝对最大额定值（VSS=0V，Ta=25℃，除非特别说明。）

项 目	符 号	规 格	单 位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V_{DD}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+10$	V
OC 输出端子电压	V_{OC}	$V_{DD}-15 \sim V_{DD}+0.3$	V
OD 输出端子电压	V_{OD}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
CS 输入端子电压	V_{CS}	$V_{DD}-15 \sim V_{DD}+0.3$	V
工作温度范围	T_{OP}	-40~+85	℃
储存温度范围	T_{ST}	-40~+125	℃
容许功耗（热阻 $\theta_{JA}=115^{\circ}\text{C/W}$ ）	P_D	1.1 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	W



注：超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

8. 电气特性

表 4、 电气参数（VSS=0V，Ta=25℃，除非特别说明。）

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
VDD-VSS 工作电压	V _{DSOP1}	-	1.5	-	8	V
VDD-CS 工作电压	V _{DSOP2}	-	1.5	-	15	V
耗电流						
工作电流	I _{DD}	V _{DD} =3.9V	-	3.0	6.0	μA
休眠电流	I _{OD}	V _{DD} =2.0V	-	-	0.1	μA
检测电压						
过充电检测电压	V _{CU}		4.250	4.280	4.310	V
过充电释放电压	V _{CR}		4.030	4.080	4.130	V
过放电检测电压	V _{DL}		2.950	3.000	3.050	V
过放电释放电压	V _{DR}		2.950	3.000	3.050	V
放电过流检测电压	V _{DIP}	V _{DD} =3.6V	65	80	95	mV
负载短路检测电压	V _{SIP}	V _{DD} =3.9V	0.360	0.580	0.800	V
充电过流检测电压	V _{CIP}	V _{DD} =3.6V	-140	-100	-60	mV
延迟时间参数						
过充电检测延迟时间	T _{OC}	V _{DD} =3.9V→4.5V	1000	1300	1600	ms
过放电检测延迟时间	T _{OD}	V _{DD} =3.6V→2.0V	115	145	175	ms
放电过流检测延迟时间	T _{DIP}	V _{DD} =3.6V,CS=0.4V	6.75	9	11.25	ms
充电过流检测延迟时间	T _{CIP}	V _{DD} =3.6V,CS=-0.2V	6	8	10	ms
负载短路检测延迟时间	T _{SIP}	V _{DD} =3.0V,CS=1.3V	200	300	400	μs
控制端子输出电压						
OD 端子输出高电压	V _{DH}		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OD 端子输出低电压	V _{DL}		-	0.1	0.5	V
OC 端子输出高电压	V _{CH}		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OC 端子输出低电压	V _{CL}		-	0.1	0.5	V
向 0V 电池充电的功能						
充电器起始电压（允许向 0V 电池充电功能）	V _{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
短路保护电流	I _{short}	VDD=4.0V	7.6	14.5	22.9	A
过流检测电流	I _{OC}	VDD=3.6V	1.35	2.0	2.75	A
内部MOSFET耐压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V I _D 250uA	20			V
内部MOSFET内阻	R _{on}	VDD=3.6V@1A	35	40	47	mΩ

表 5、电气参数（延迟时间参数除外。VSS=0V，Ta=-20℃~60℃ *1）

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
VDD-VSS 工作电压	V _{DSOP1}	-	1.5	-	8	V
VDD-CS 工作电压	V _{DSOP2}	-	1.5	-	15	V
耗电流						
工作电流	I _{DD}	V _{DD} =3.9V	-	3.0	6.0	μA
休眠电流	I _{OD}	V _{DD} =2.0V	-	-	0.1	μA
检测电压						
过充电检测电压	V _{CU}		4.240	4.280	4.320	V
过充电释放电压	V _{CR}	3.8~4.5V,可调整	4.025	4.080	4.135	V
过放电检测电压	V _{DL}	2.0~3.1V,可调整	2.935	3.000	3.065	V
过放电释放电压	V _{DR}	2.0~3.4V,可调整	2.935	3.000	3.065	V
放电过流检测电压	V _{DIP}	V _{DD} =3.6V	55	80	105	mV
负载短路检测电压	V _{SIP}	V _{DD} =3.9V	0.36	0.580	0.880	V
充电过流检测电压	V _{CIP}	V _{DD} =3.6V	-150	-100	-50	mV
延迟时间参数						
过充电检测延迟时间	T _{OC}	V _{DD} =3.9V→4.5V	800	1300	1800	ms
过放电检测延迟时间	T _{OD}	V _{DD} =3.6V→2.0V	95	145	195	ms
放电过流检测延迟时间	T _{DIP}	V _{DD} =3.6V, CS=0.4V	5.625	9	12.375	ms
充电过流检测延迟时间	T _{CIP}	V _{DD} =3.6V, CS=-0.2V	5	8	11	ms
负载短路检测延迟时间	T _{SIP}	V _{DD} =3.0V, CS=1.3V	140	300	460	μs
控制端子输出电压						
OD 端子输出高电压	V _{DH}		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OD 端子输出低电压	V _{DL}		-	0.1	0.5	V
OC 端子输出高电压	V _{CH}		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OC 端子输出低电压	V _{CL}		-	0.1	0.5	V
向 0V 电池充电的功能						
充电器起始电压（允许向 0V 电池充电功能）	V _{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
短路保护电流	I _{short}	VDD=4.0V	7.6	14.5	25	A
过流检测电流	I _{OC}	VDD=3.6V	1.15	2.0	3.0	A
内部MOSFET耐压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V I _D 250uA	20			V
内部MOSFET内阻	R _{on}	VDD=3.6V@1A	35	40	47	mΩ

说明：*1、此温度范围内的参数是设计保证值，而非高、低温实测筛选。

9. 电池保护 IC 应用电路示例

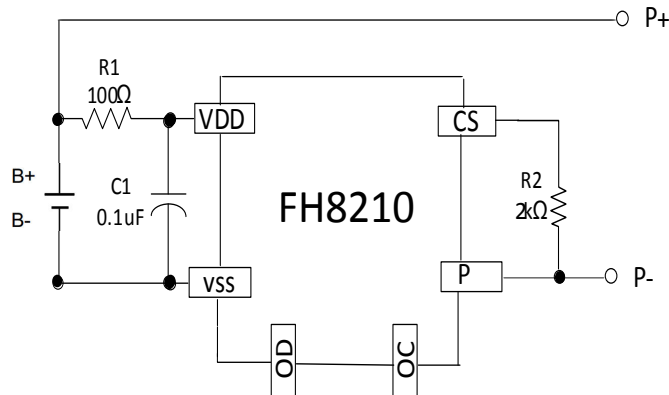


图3-1 FH8210典型应用电路1

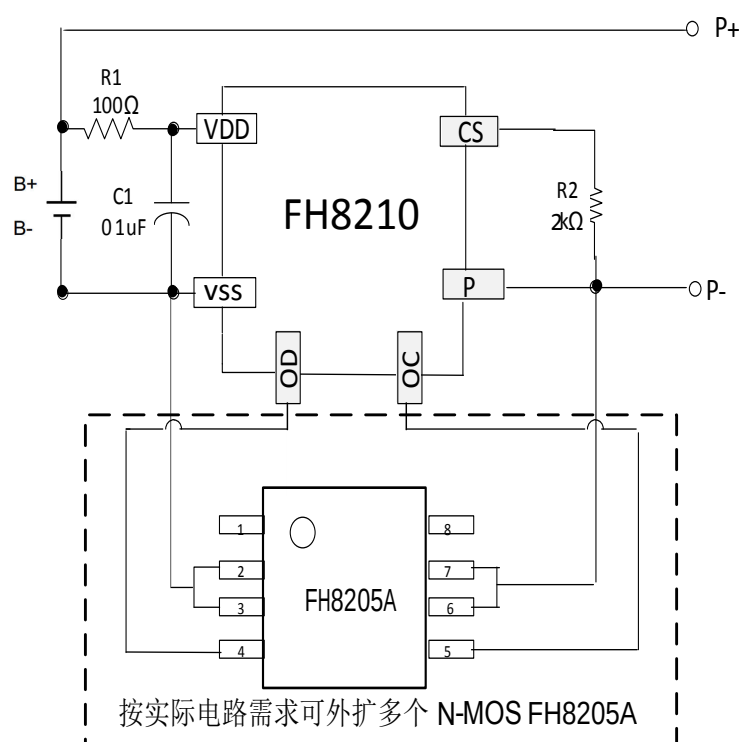


图3-2 FH8210典型应用电路2

标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定 VDD、加强 ESD	100Ω	100Ω	200Ω	*1
R2	电阻	限流	1kΩ	2kΩ	2kΩ	*2
C1	电容	滤波，稳定 VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制（FH8205为双MOS）	-	-	-	*4
M2	N MOSFET	充电控制（FH8205为双MOS）	-	-	-	*5

*1、R1 连接过大电阻，由于耗电流会在 R1 上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向 IC，若 R1 过大有可能导致 VDD VSS 端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

*2、R2 连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

*3、C1 有稳定 VDD 电压的作用，请不要连接 0.01μF 以下的电容。

*4、使用 MOSFET 的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET 有可能被损坏。

注意：

- 1. 上述参数有可能不经预告而作更改，请及时与业务部联系获取最新版规格。
- 2. 外围器件如需调整，建议客户进行充分的评估和测试。
- 3. 以上说明中，M2为外接OC控制端MOS，M1为外接OD端控制MOS。

10. 工作说明

10.1. 正常工作状态

此 IC 持续侦测连接在 VDD 和 VSS 之间的电池电压，以及 CS 与 VSS 之间的电压差，来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(VDL)以上并在过充电检测电压(VCU)以下，且 CS 端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时，IC 的 OC 和 OD 端子都输出高电平，使充电控制用 MOSFET 和放电控制用 MOSFET 同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接 CS 端子和 VSS 端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

10.2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，一旦电池电压超过过充电检测电压(VCU)，并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(TOC)以上时，FH8210 系列 IC 会关闭充电控制用的 MOSFET (OC 端子)，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。过充电状态在如下 2 种情况下可以释放：

不连接充电器时：

(1) 由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接负载放电，放电电流先通过充电控制用 MOSFET 的寄生二极管流过，此时 CS 端子侦测到一个“二极管正向导通压降(Vf)”的电压。当 CS 端子电压在放电过流检测电压(VDIP)以上且电池电压降低到过充电检测电压(VCU)以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池电压低于过充电释放电压(VCR)，过充电状态也不能释放。断开充电器，CS 端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)以上时，过充电状态才能释放。

10.3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时，FH8210 系列 IC 会关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子)，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当关闭放电控制用 MOSFET 后，CS 由 IC 内部电阻上拉到 VDD，使 IC 耗电流减小

到休眠时的耗电流值，这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态的释放，有以下两种情况：

（1）连接充电器，若 CS 端子电压低于充电过流检测电压（VCIP），当电池电压高于过放电检测电压（VDL）时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

（2）连接充电器，若 CS 端子电压高于充电过流检测电压（VCIP），当电池电压高于过放电释放电压（VDR）时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

10.4. 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能）

正常工作状态下的电池，FH8210 系列 IC 通过检测 CS 端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS 端子电压超过放电过流检测电压（VDIP），并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间（TDIP），则关闭放电控制用的 MOSFET（OD 端子），停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦 CS 端子电压超过负载短路检测电压（VSIP），并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间（TSIP），则也关闭放电控制用的 MOSFET（OD 端子），停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

当连接在电池正极（PB+）和电池负极（PB-）之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗（典型值约 300kΩ）时，放电过流状态和负载短路状态释放，恢复到正常工作状态。另外，即使连接在电池正极（PB+）和电池负极（PB-）之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗，当连接上充电器，CS 端子电压降低到放电过流保护电压（VDIP）以下，也会释放放电过流状态或负载短路状态，回到正常工作状态。

注意：

若不慎将充电器反接时，回路中的电流方向与放电时电流方向一致，如果 CS 端子电压高于放电过流检测电压（VDIP），则可以进入放电过流保护状态，切断回路中的电流，起到保护的作用。

10.5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压（VCIP），并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间（TCIP），则关闭充电控制用的 MOSFET（OC 端子），停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使 CS 端子电压高于充电过流检测电压（VCIP）时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

10.6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极（PB+）和电池负极（PB-）之间的充电器电压，高于“向 0V 电池充电的充电器起始电压（ V_{0CH} ）”时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通（OC 端子），开始充电。这时，放电控制用 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压（ V_{DL} ）时，FH8210 系列 IC 进入正常工作状态。

注意：

（1）某些完全自放电后的电池，不允许被再次充电，这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

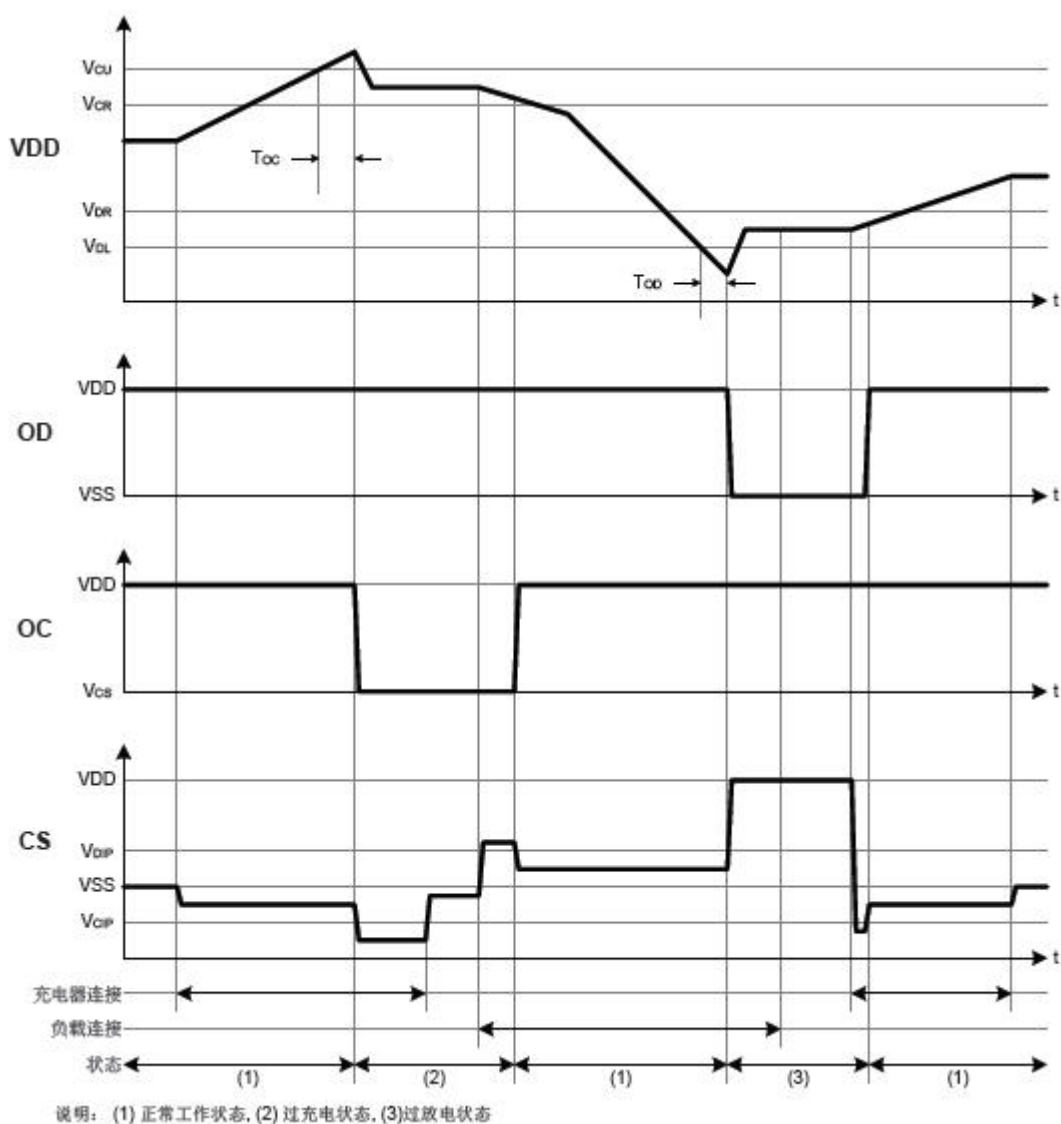
（2）“允许向 0V 电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此，使用“允许向 0V 电池充电”功能的 IC，在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压（ V_{DL} ）以下时，不能进行充电过流状态的检测。

11 .PCB 布线注意事项

- 1、C1对IC的VDD电压滤波，所以PCB布线时，C1尽量靠近IC的VDD脚，以免降低其滤波效果。
- 2、充放电电流都经过P-和VSS脚形成回路，在对P-和VSS布线时，尽量加大其铜皮宽度，降低单位电流密度，能减少线路损耗及发热。
- 3、如果需要并联MOS管，需要注意并联MOS与内置MOS管P-和VSS并联铜皮尽量宽度一致，避免两组MOS管因铜皮面积差异导致流经电流不均匀引起其中一组MOS发热偏高或易损坏。
- 4、如果线路并联了1个以上MOS管，测试保护板整体内阻严重偏高计算后的理论值，需检查 PCB布线是否合理，主要确定上述注意事项 第3条。

11. 时序图

(1) 过充电检测，过放电检测

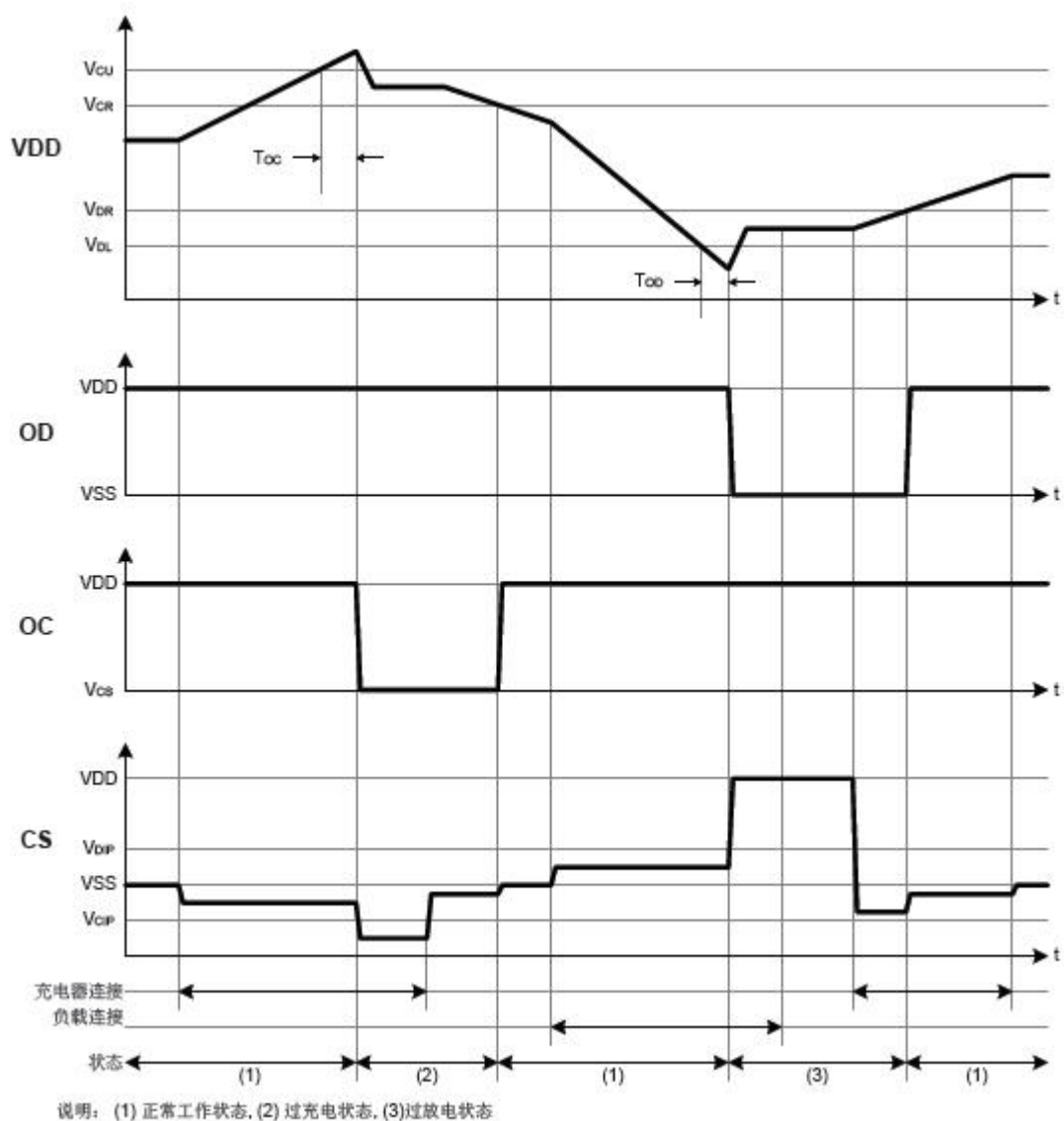


说明:

(a) 过充释放条件: $V_{CS} > V_{DIP}$ & $V_{DD} < V_{CU}$ 。

(b) 过放释放条件: $V_{CS} < V_{CIP}$ & $V_{DD} > V_{DL}$ 。

(2) 过充电检测，过放电检测

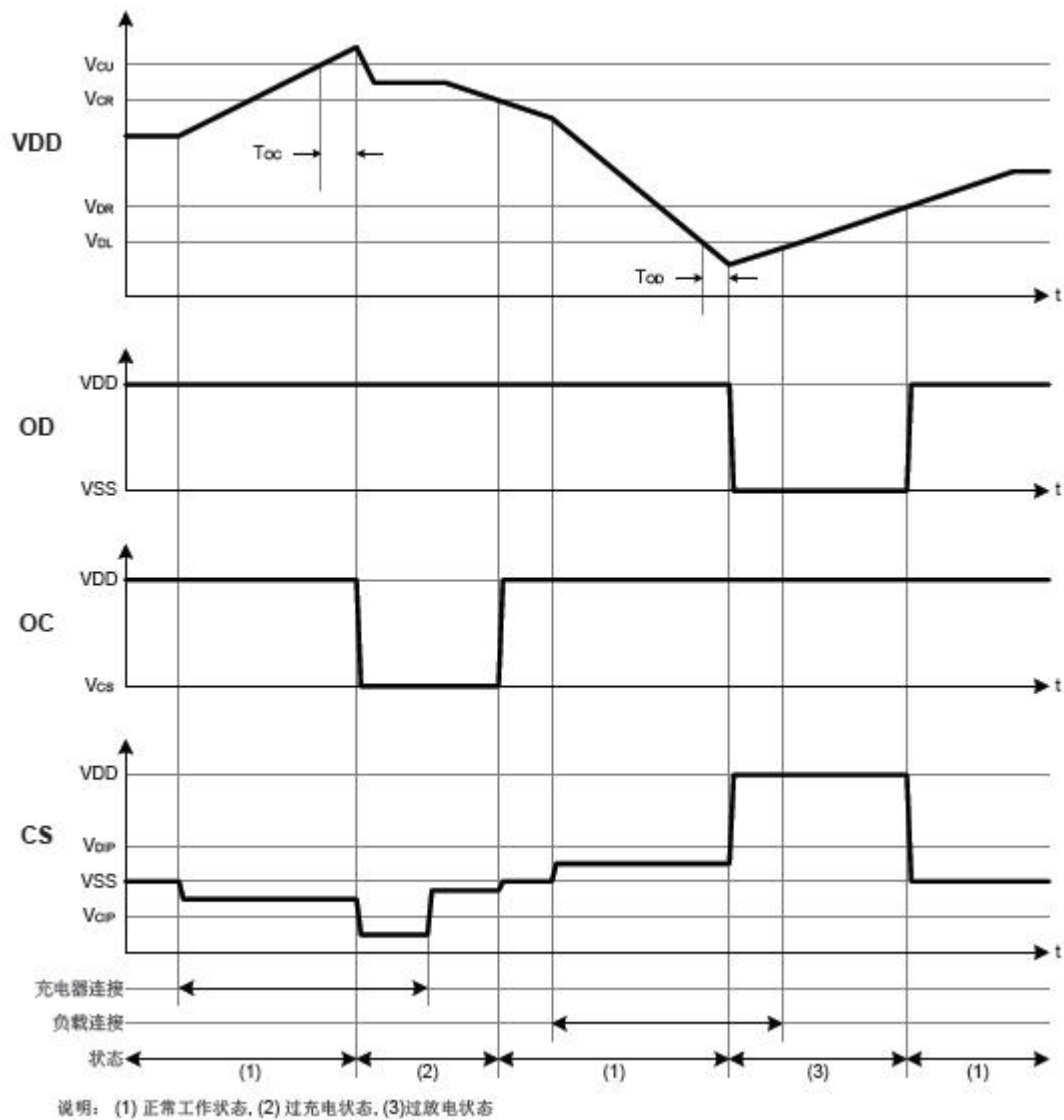


说明:

(a) 过充释放条件: $V_{CIP} < V_{CS} < V_{DIP}$ & $V_{DD} < V_{CR}$ 。

(b) 过放释放条件: $V_{CS} > V_{CIP}$ & $V_{DD} > V_{DR}$ 。

(3)过充电检测，过放电检测（有过放自恢复功能）

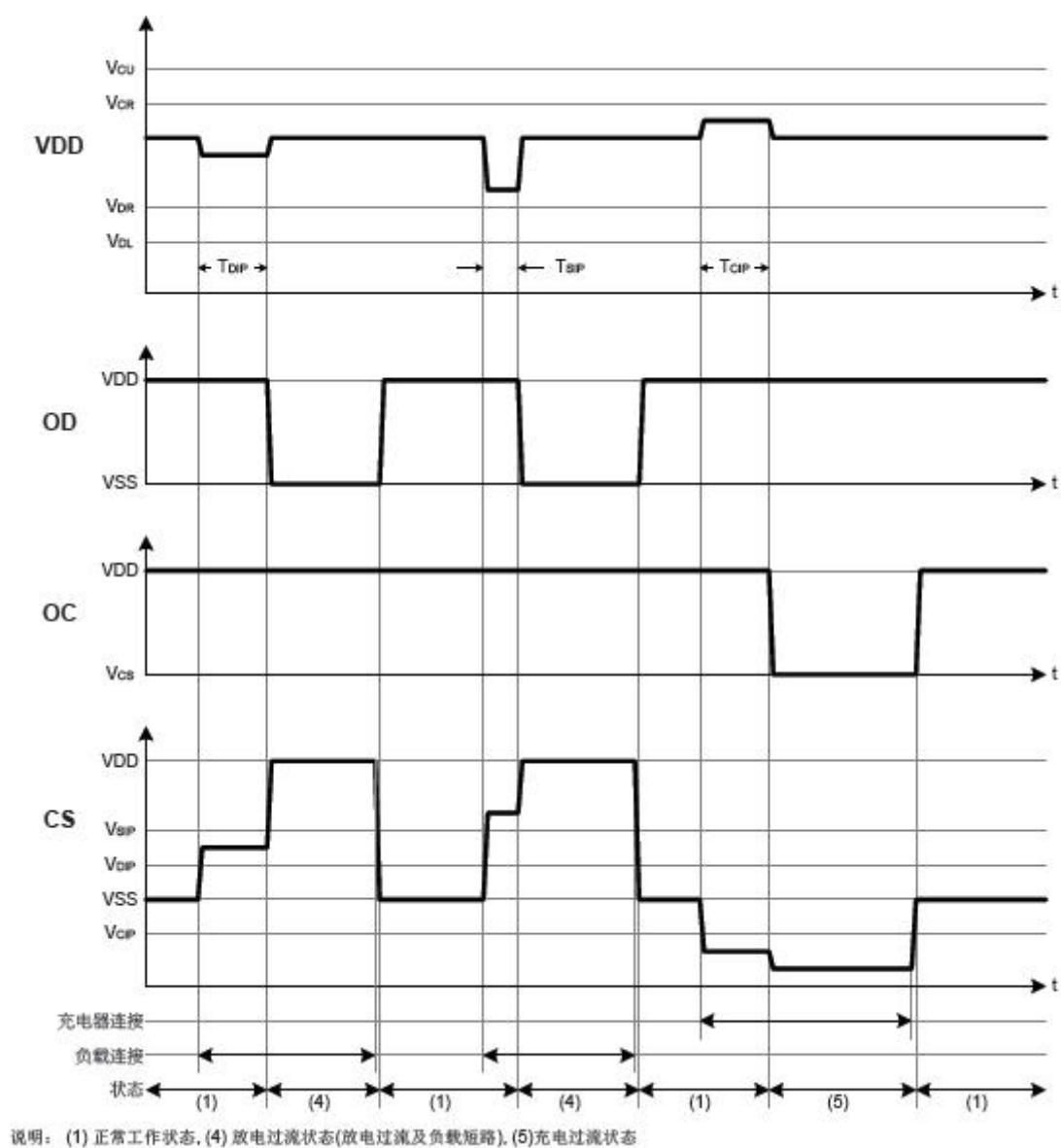


说明:

(a) 过充释放条件: $V_{CIP} < V_{CS} < V_{DIP}$ & $V_{DD} < V_{CR}$ 。

(b) 过放释放条件: $V_{DD} > V_{DR}$ 。

(4)放电过流检测，负载短路检测，充电过流检测



封装尺寸
CPC-8

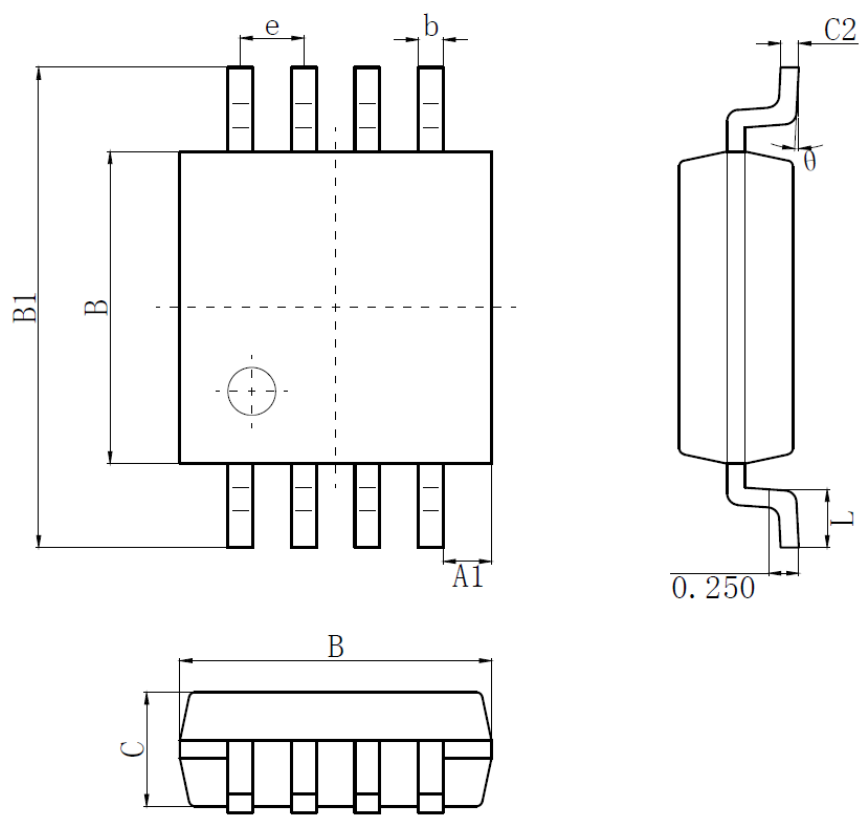


图 CPC-8 封装外形尺寸 表 5

SYMBOL	MIN(mm)	MAX(mm)	SYMBOL	MIN(mm)	MAX(mm)
A	2.50	2.70	C	0.85	1.05
A1	0.35	0.45	C1	0.00	0.15
e	0.53(BSC)		C2	0.15	0.18
B	2.50	2.70	L	0.40	0.60
B1	3.85	4.15	θ	0°	8°
b	0.16	0.26			

注意：

- 1、本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时与业务部联系。
- 2、本规格书中的图形、应用电路等，因第三方工业所有权引发的问题，本公司不承担其责任。
- 3、本产品单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。使用在客户的产品或设备中，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
- 4、请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出说明书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此所造成的损失，本公司不承担任何责任。
- 5、本产品虽内置防静电保护电路，但请不要施加超过保护电路性能的过大静电。
- 6、本规格书中的产品，未经书面许可，不可使用在要求高可靠性的电路中。例如健康医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械及航空器械等对人体产生影响的器械或装置，不得作为其部件使用。
- 7、本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标，这样可以避免事故的发生。
- 8、本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的之转载或复制。